

ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ

ДВАДЦЯТА МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ



СУЧАСНІ ІНФОРМАШІЙНІ ТА ЕЛЕКТРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ

27–31 травня 2019 року
Україна, м. Одеса

Реквізити для зв'язку
e-mail <tkea@optima.com.ua>
тел. +38 (048) 728-49-46.

- Інформаційні технології в електроніці та телекомунікаціях
- Радіотехнічні, телекомунікаційні та телевізійні системи. Захист інформації в широкосмугових системах та комп'ютерних мережах
- Проектування, конструювання, виробництво та контроль електронних засобів
- Функціональна електроніка. Мікро- та нанотехнології

Плановані публікації
Труди конференції з тезами доповідей
Збірник доповідей (статей)
у видавництві Springer

www.tkea.com.ua/siet/inf.html



5–6 2018
СЕНТЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЕ»**

ISSN 2225-5818

Выходит один раз в 2 месяца

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

К. т. н. А. Ф. Бондаренко
(КПИ им. Игоря Сикорского, г. Киев, Украина)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

*Акад. НАНУ, г. ф.-м. н. А. Е. Беляев (г. Киев, Украина)
Д. т. н. Н. М. Вакив (г. Львов, Украина)
Д. т. н. Г. А. Оборский (г. Одесса, Украина)
К. т. н. В. М. Чмиль В. (г. Киев, Украина)
Е. А. Тихонова (г. Одесса, Украина)*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

*Д. т. н. С. Г. Антощук (г. Одесса, Украина)
Д. т. н. А. П. Бондарев (г. Львов, Украина)
Prof. I. Vajda (Budapest, Hungary)
Prof. D. Vinnikov (Tallinn, Estonia)
Prof. I. Galkin (Riga, Latvia)
К. т. н. Э. Н. Глущенко (г. Киев, Украина),
зам. главного редактора
К. т. н. Г. Г. Горох (г. Минск, Республика Беларусь)
Prof. K. Dhoska (Tirana, Albania)
Д. ф.-м. н. В. В. Должиков (г. Харьков, Украина)
Д. т. н. А. А. Дружинин (г. Львов, Украина)
Д. т. н. А. А. Ефименко (г. Одесса, Украина),
зам. главного редактора
Д. ф.-м. н. Д. В. Корбутяк (г. Киев, Украина)
Д. т. н. С. И. Круковский (г. Львов, Украина)
Д. т. н. С. Ю. Лузин (г. С.-Петербург, Российская
Федерация)
Чл.-кор. НАНУ, г. ф.-м. н. В. С. Лысенко (г. Киев,
Украина)*

*Prof. J. Martins (Caparica, Portugal)
Д. т. н. И. Ш. Невлюдов (г. Харьков, Украина)
Dr. Sc. D. Nika (Chisinau, Moldova)
Д. т. н. Ю. Е. Николаенко (г. Киев, Украина)
Prof. V. Pires (Setúbal, Portugal)
Д. ф.-м. н. С. В. Плаксин (г. Днепропетровск,
Украина)
К. т. н. Прокопец В. М. (г. Киев, Украина)
Prof. E. Romero-Cadaval (Badajoz, Spain)
К. ф.-м. н. А. В. Рыбка (г. Харьков, Украина)
К. т. н. П. С. Сафонов (г. Одесса, Украина),
отв. секретарь редколлегии
Д. т. н. В. Н. Сидорец (г. Киев, Украина)
Д. т. н. В. С. Ситников (г. Одесса, Украина)
Dr. Sc. Z. Stević (Belgrade, Serbia)
Д. х. н. В. Н. Томашик (г. Киев, Украина)
К. т. н. В. Е. Трофимов (г. Одесса, Украина)*

Подписка на журнал

Отделения связи. «Каталог видань України». Индекс 23785.
В редакции «ТКЭА» можно подписаться с любого номера.

Контактная информация

Украина, 65044, г. Одесса, а/я 17;
tkea@optima.com.ua, www.tkea.com.ua,
+38 (048)728-49-46.

Редакция

Е. А. Тихонова, А. А. Ефименко, П. С. Сафонов,
А. А. Алексеева, М. Г. Глава, Н. М. Колганова, Е. И. Корецкая.

**ТЕХНОЛОГИЯ
И
КОНСТРУИРОВАНИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЕ**

Зарегистрирован
в ВАК Украины
по разделам
«Физико-математические науки»,
«Технические науки»

Реферируется
в УРЖК «Джерело»
(г. Киев)

Журнал включен
в международную справочную
систему по периодическим
и продолжающимся изданиям
“Ulrich’s Periodicals Directory”
(США),

в международную систему
библиографических ссылок
CrossRef,
в научометрическую базу РИНЦ,
в базу данных DOAJ,
в Google Scholar

Номер выпущен при поддержке
ОНПУ (г. Одесса),
НПП «Сатурн» (г. Киев),
НПП «Карат» (г. Львов)

Одобрено к печати
Ученым советом ОНПУ
(Протокол № 4 от 18.12.2018 г.)
Отв. за выпуск: Е. А. Тихонова

УЧРЕДИТЕЛИ
Институт физики полупроводников им. В. Е. Лашкарёва
Научно-производственное предприятие «Сатурн»
Одесский национальный политехнический университет
Изательство «Политехпериодика»

Свидетельство о регистрации
№ КВ 21788-11688ПР
от 21.12.2015 г.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2018 № 5–6

Год издания 42-й

СОДЕРЖАНИЕ

Современные электронные технологии

Обнаруживающая способность псевдокольцевых тестов по отношению к динамическим одиночным неисправностям в словоориентированной памяти.
Грицков С. С., Сорокин Г. Ф., Шестакова Т. В. (на английском)

3

Электронные средства: исследования, разработки

Рентгеновское излучение, вызванное импульсным лазерным воздействием на опаловые матрицы.
Белянин А. Ф., Борисов В. В., Попов В. В. (на английском)

10

Системы передачи и обработки сигналов

Исследование корректирующей способности синхрокодов для модели декодера с согласованной обработкой.
Садченко А. В., Кушниренко О. А., Юркевич А. Г., Севастьянов В. С.

17

Влияние параметров детектора на эффективность приема радиосигналов со сложной фазовой модуляцией.
Максымчук И. П., Алтунин С. И., Бондарев А. П., Горбатый И. В. (на украинском)

24

Обеспечение тепловых режимов

CFD-моделирование импактно-струйного радиатора для проведения термотренировки микропроцессоров.
Трофимов В. Е., Павлов А. Л., Сторожук А. С.

30

Материалы электронники

Исследование кристаллов $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ и гетеропереходов на их основе.
Ковалюк Т. Т., Майструк Э. В., Солован М. Н., Козярский И. П., Марьинчук П. Д.

37

Исследование ширины запрещенной зоны смешанных кристаллов $\text{ZnS}_x\text{Se}_{1-x}$.
Трубаева О. Г., Чайка М. А.

44

Влияние температуры на оптические свойства тонких пленок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$.
Майструк Э. В., Козярский И. П., Козярский Д. П., Марьинчук П. Д. (на украинском)

50

Список рецензентов номера

55

Памятка для авторов журнала

55

ЗМІСТ

CONTENTS

Сучасні електронні технології

Виявляюча здатність псевдокільцевих тестів по відношенню до динамічних одиночних несправностей в словоорієнтованій пам'яті. *Гріцков С. С., Сорокін Р. Ф., Шестакова Т. В.* (3)

Електронні засоби: дослідження, розробки

Рентгенівське випромінювання, що викликане імпульсною лазерною дією на опалові матриці. *Белянін А. Ф., Борисов В. В., Попов В. В.* (10)

Системи передачі та обробки сигналів

Дослідження коригувальної здатності синхрокодів для моделі декодеру з узгодженою обробкою. *Садченко А. В., Кушніренко О. А., Юркевич А. Г., Севаст'янів В. С.* (17)

Вплив параметрів детектора на ефективність приймання радіосигналів зі складною фазовою модуляцією. *Максимів І. П., Алтунін С. І., Бондарєв А. П., Горбатий І. В.* (24)

Забезпечення теплових режимів

CFD-моделювання імпактно-струменевого радіатора для проведення термотренування мікропроцесорів. *Трофімов В. Є., Павлов О. Л., Сторожук О. С.* (30)

Матеріали електроніки

Дослідження кристалів $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ та гетеропереходів на їхній основі. *Ковалюк Т. Т., Маїструк Е. В., Солован М. М., Козярський І. П., Мар'янчук П. Д.* (37)

Дослідження ширини забороненої зони в змішаних кристалах $\text{ZnS}_x\text{Se}_{1-x}$. *Трубаєва О. Г., Чайка М. А.* (44)

Вплив температури на оптичні властивості тонких плівок $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$. *Маїструк Е. В., Козярський І. П., Козярський Д. П., Мар'янчук П. Д.* (50)

Modern electronic technologies

Pseudo-ring tests resolution for dynamic single faults in word-oriented memory. *Gritcov S. S., Sorokin G. F., Shestacova T. V.* (3)

Electronic devices: research, development

X-ray radiation during pulsed laser treatment of opal matrices. *Belyanin A. F., Borisov V. V., Popov V. V.* (10)

Signals transfer and processing systems

Study of the corrective ability of sync codes for the matched processing decoder. *Sadchenko A. V., Kushnirenko O. A., Yurkevych A. G., Sevastianov V. S.* (17)

The influence of detector's parameters on the efficiency of radio signals with complex phase modulation receiving. *Maksymiv I. P., Altunin S. I., Bondariev A. P., Horbatyi I. V.* (24)

Thermal management

CFD-simulation of impact jet radiator for thermal testing of microprocessors. *Trofimov V. E., Pavlov A. L., Storozhuk A. S.* (30)

Materials of electronics

Study on $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$ crystals and heterojunctions on their basis. *Kovaliuk T. T., Maistruk E. V., Solovan M. N., Koziarskyi I. P., Maryanchuk P. D.* (37)

Investigation of band gap width in mixed $\text{ZnS}_x\text{Se}_{1-x}$ crystals. *Trubaieva O. G., Chaika M. A.* (44)

Influence of temperature on optical properties of thin films $\text{Cu}_2\text{ZnSnSe}_4$. *Maistruk E. V., Koziarskyi I. P., Koziarskyi D. P., Maryanchuk P. D.* (50)